

Красников Геннадий Яковлевич

Академик РАН, профессор, д.т.н.

Родился 30 апреля 1958г. в Тамбове. В 1981г. с отличием окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники. В этом же году пришел на работу в НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) с опытным заводом «Микрон».

Пройдя последовательно все должности, в 1987 г. стал заместителем генерального директора, а в 1991 г. стал директором НИИМЭ с опытным заводом «Микрон». В 1994 г. стал генеральным директором АО «НИИМЭ и «Микрон» и являлся им по 2016 г.

В настоящее время является генеральным директором АО «НИИМЭ», председателем совета директоров ПАО «Микрон» и председателем совета директоров АО «НИИТМ» (НИИ точной механики).

Член-корреспондент РАН (1997), академик РАН (2008) по Отделению нанотехнологий и информационных технологий.

В 2016 году решением президента РФ В.В. Путина академик Г.Я. Красников был наделен полномочиями руководителя приоритетного технологического направления по электронным технологиям, а возглавляемый им АО «НИИМЭ» распоряжением Правительства РФ определен организацией, ответственной за реализацию данного приоритетного технологического направления.

Руководитель межведомственного Совета главных конструкторов по электронной компонентной базе РФ, член НТС Военно-промышленной комиссии РФ, Председатель научного Совета РАН «Физико-химические основы полупроводникового материаловедения», член Консультативного научного Совета Инновационного центра «Сколково», член наблюдательного Совета Новосибирского национального исследовательского государственного университета и Национального исследовательского университета «МИЭТ», почетный доктор Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета Российской академии наук. Член двух экспертных советов по присуждению премии Правительства РФ в области науки и техники.

Входит в состав Совета руководителей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА Leadership Council) Глобального альянса производителей полупроводников (Global Semiconductor Alliance), содействуя укреплению существующих и установлению новых партнерских связей с лидерами мировой микроэлектроники в области научно-технической кооперации.

Возглавляет базовую кафедру «Микро- и наноэлектроники» в Московском физико-техническом институте (ГУ) и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском университете «МИЭТ», руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники.

Главный редактор журналов «Микроэлектроника», «Электронная техника. Серия микроэлектроника», «Интеллект&Технологии», член редколлегии журналов «Известия высших учебных заведений. Электроника», «Электроника. Наука. Технология. Бизнес», «Нано - и микросистемная техника», «Труды МФТИ».

Г.Я. Красников – крупный ученый с мировым именем в области физики полупроводников, диэлектриков и гетероструктур на их основе, технологии создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и проблемам обеспечения качества их промышленного производства. Автор и соавтор более 360 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, четырех научных монографий и более 40 авторских свидетельств и патентов.

Академиком Красниковым созданы научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами на всем технологическом маршруте изготовления интегральных микросхем. Разработанные с применением новых методов интегральные микросхемы позволили решить ряд важнейших для страны задач обеспечения государственной безопасности. При непосредственном участии Г.Я. Красникова отечественной электронной промышленностью были освоены в производстве более 200 типов микросхем, разработанных НИИМЭ для создания оборонной техники, которые выпускались ранее за пределами РФ.

Научные результаты, отраженные в монографиях Г.Я. Красникова, легли в основу создания при его непосредственном руководстве современного уникального комплекса по разработке и промышленному производству интегральных микросхем уровня 180-90-65нм в г. Зеленоград, на базе которых реализованы стратегические государственные проекты в области телекоммуникации и связи, медицины и транспорта, национальной банковской системы, выпуска государственных электронных документов, создания передовой космической и авиационной техники. Реализация этого проекта позволила начать программу импортозамещения элементной базы, используемой в российской радиоэлектронной промышленности и сформировать задел для создания собственной технологии производства интегральных микросхем современного уровня 28нм и менее.

Научная школа академика Г.Я. Красникова и компетенции возглавляемой им организации позволили разработать технологии, критически важные для обеспечения государственной безопасности и запрещенные к экспорту в Россию. Создаваемые по новым технологиям интегральные микросхемы обладают серьезным потенциалом для широкого практического применения и способны в долгосрочном периоде обеспечить национальную безопасность и технологическую независимость страны.

Разработанные под руководством академика Г.Я. Красникова новые современные изделия микроэлектроники успешно конкурируют с зарубежными аналогами на мировом рынке: российская элементная база успешно поставляется на сборочные предприятия Юго-Восточной Азии, в Европу и Северную Америку, что подтверждает высокий уровень развития, качество и надежность современных отечественных электронных технологий.

Мировому продвижению российской микроэлектроники способствует развитие международных научных связей. На постоянной основе АО «НИИМЭ» сотрудничает с зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования: IMEC (Бельгия), CEA-Leti (Франция), Technische Universiteit Delft (Голландия), Ecole Speciale de Lausanne (Швейцария), Aselta (Франция), Leland Stanford Junior University (США), Mapper Lithography (Голландия) и др. Возглавляемое Г.Я. Красниковым АО «НИИМЭ» является полноправным членом Всемирной Полупроводниковой Ассоциации (The Global Semiconductor Alliance, GSA) и представляет Россию в этой организации.

На базе НИИМЭ и ряда институтов РАН в 2015 году был создан Консорциум «Перспективные материалы и элементная база информационных и вычислительных систем», в рамках которого под руководством Г.Я. Красникова происходит объединение усилий НИИ РАН, промышленных НИИ, предприятий и организаций в получении и практической реализации фундаментальных знаний в области электронных технологий на основе оптимального сочетания и взаимодействия фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и НИОКР для обеспечения современными микроэлектронными изделиями высокотехнологичного сектора российской экономики.

Премии, призы и иные награды, свидетельствующих о признании научных достижений:

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
- Орден Почёта (1999)
- Орден Дружбы (2014)
- Медаль "В память 850-летия Москвы" (1997)
- Государственная премия РФ в области науки и технологии (2014)
- Премии Правительства РФ в области науки и техники (1999, 2009)
- Медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий (2016)